

## 11A, 700V 超结 MOS功率管

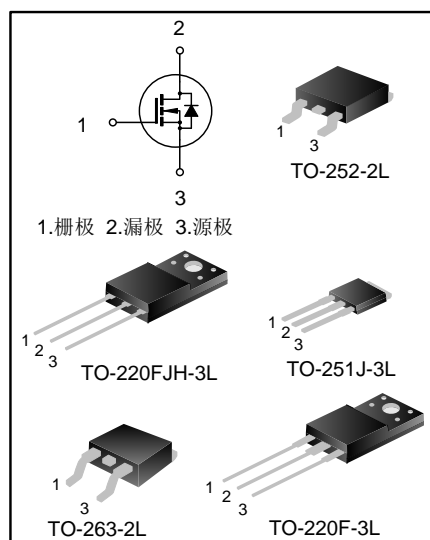
### 描述

SVSP11N70F/FJH/D/MJ/SD2 N 沟道增强型高压功率 MOSFET 采用士兰微电子超结 MOS 技术制造，具有很低的传导损耗和开关损耗。使得功率转换器具有高效，高功率密度，提高热行为。

此外，SVSP11N70F/FJH/D/MJ/SD2 应用广泛。如，适用于硬/软开关拓扑。

### 特点

- ◆ 11A,700V,  $R_{DS(on)}$ (典型值)= $0.37\Omega @ V_{GS}=10V$
- ◆ 创新高压技术
- ◆ 低栅极电荷
- ◆ 定期额定雪崩
- ◆ 较强  $dv/dt$  能力
- ◆ 高电流峰值



### 产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SVSP11N70FD2	TO-220F-3L	P11N70FD2	无卤	料管
SVSP11N70FJHD2	TO-220FJH-3L	P11N70FJH	无卤	料管
SVSP11N70DD2TR	TO-252-2L	P11N70D	无卤	编带
SVSP11N70MJD2	TO-251J-3L	P11N70MJD2	无卤	料管
SVSP11N70SD2	TO-263-2L	P11N70SD2	无卤	料管

极限参数(除非特殊说明,  $T_C=25^{\circ}\text{C}$ )

参数	符号	参数范围			单位
		SVSP11N70 FD2/FJHD2	SVSP11N70 DD2/MJD2	SVSP11N70 SD2	
漏源电压	$V_{DS}$	700			V
栅源电压	$V_{GS}$	$\pm 30$			V
漏极电流	$I_D$	$T_C=25^{\circ}\text{C}$			A
		$T_C=100^{\circ}\text{C}$			
漏极脉冲电流	$I_{DM}$	44			A
耗散功率( $T_C=25^{\circ}\text{C}$ ) 大于 $25^{\circ}\text{C}$ 每摄氏度减少	$P_D$	37	130	139	W
		0.3	1.0	1.1	W/ $^{\circ}\text{C}$
单脉冲雪崩能量(注 1)	$E_{AS}$	576			mJ
反向二极管 $dv/dt$ (注 2)	$dv/dt$	15			V/ns
MOS管 $dv/dt$ 耐用性(注 3)	$dv/dt$	50			V/ns
工作结温范围	$T_J$	$-55\sim+150$			$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围	$T_{stg}$	$-55\sim+150$			$^{\circ}\text{C}$

## 热阻特性

参数	符号	参数范围			单位
		SVSP11N70 FD2/FJHD2	SVSP11N70 DD2/MJD2	SVSP11N70 SD2	
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	3.4	0.96	0.9	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	62.5	62.5	$^{\circ}\text{C/W}$

**电气参数(除非特殊说明,  $T_c=25^\circ\text{C}$ )**

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	$BV_{DSS}$	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	700	--	--	V
漏源漏电流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=700V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	$\mu A$
栅源漏电流	$I_{GSS}$	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	$\pm 100$	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V
静态漏源导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=5.5A$	--	0.37	0.42	$\Omega$
栅电阻	$R_g$	$f=1\text{MHz}$	--	4.7	--	$\Omega$
输入电容	$C_{iss}$	$f=1\text{MHz}, V_{GS}=0V,$ $V_{DS}=100V$	--	673	--	pF
输出电容	$C_{oss}$		--	37	--	
反向传输电容	$C_{rss}$		--	2.3	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=350V, V_{GS}=10V, R_G=24\Omega,$ $I_D=11A$ (注 4,5)	--	14	--	ns
开启上升时间	$t_r$		--	37	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	70	--	
关断下降时间	$t_f$		--	33	--	
栅极电荷量	$Q_g$	$V_{DD}=560V, V_{GS}=10V, I_D=11A$ (注 4,5)	--	24	--	nC
栅极-源极电荷量	$Q_{gs}$		--	5.2	--	
栅极-漏极电荷量	$Q_{gd}$		--	12	--	

**源-漏二极管特性参数**

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
连续源极电流	$I_S$	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	11	A
源极脉冲电流	$I_{SM}$		--	--	44	
二极管压降	$V_{SD}$	$I_S=11A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	$T_{rr}$	$I_S=11A, V_{GS}=0V,$ $di/dt=100A/\mu s$ (注 4)	--	374	--	ns
反向恢复电荷	$Q_{rr}$		--	3.9	--	$\mu C$

**注:**

- $L=79\text{mH}, I_{AS}=3.5A, V_{DD}=100V, R_G=25\Omega$ , 开始温度 $T_J=25^\circ\text{C}$ ;
- $V_{DS}=0\sim 400V, I_{SD}\leq 11A, T_J=25^\circ\text{C}$ ;
- $V_{DS}=0\sim 480V$ ;
- 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ , 占空比 $\leq 2\%$ ;
- 基本上不受工作温度的影响。



典型特性曲线

图 1. 输出特性

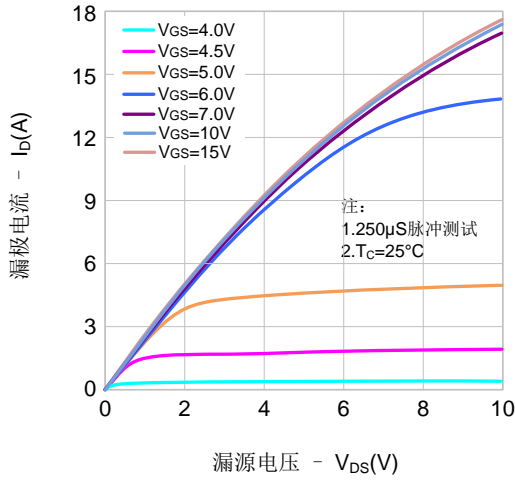


图2. 传输特性

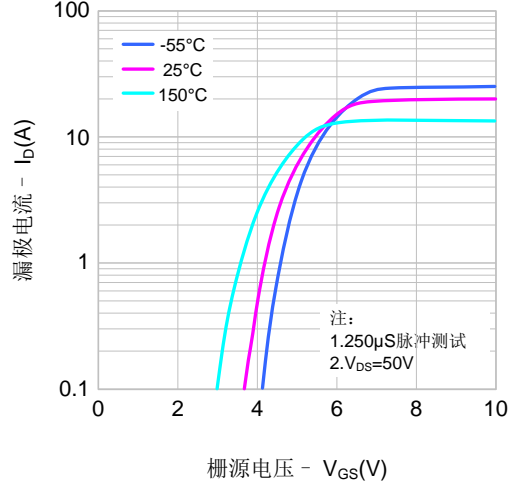


图3. 导通电阻 vs. 漏极电流、栅极电压

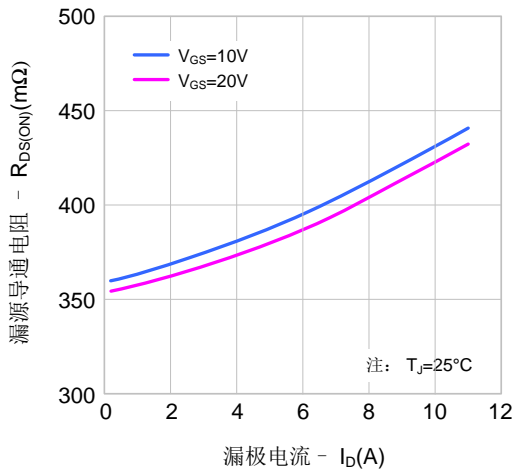


图 4. 体二极管压降 vs. 源极电流、温度

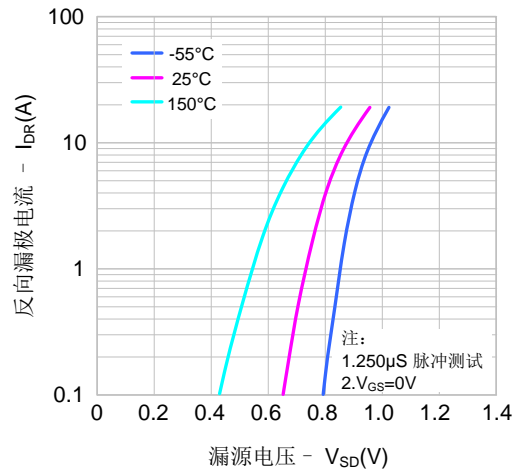


图 5. 电容特性

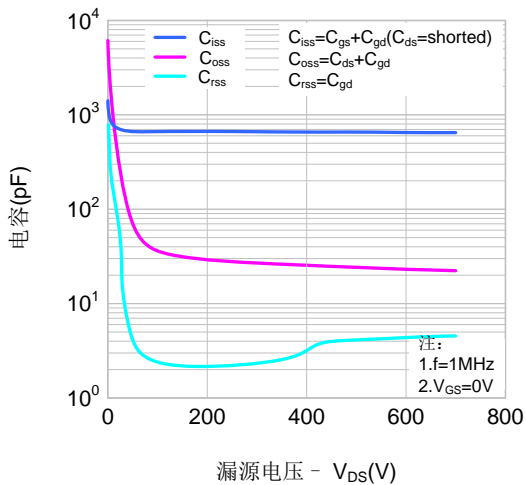
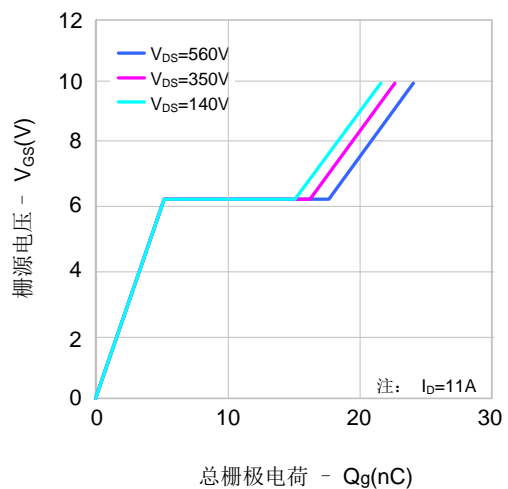


图 6. 电荷量特性





典型特性曲线 (续)

图7. 击穿电压vs.温度特性

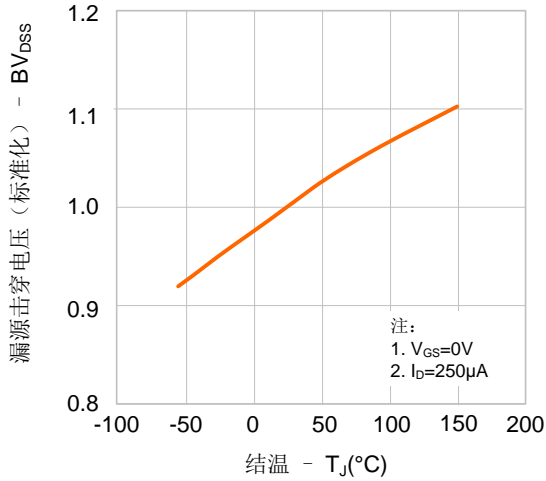


图8. 导通电阻vs.温度特性

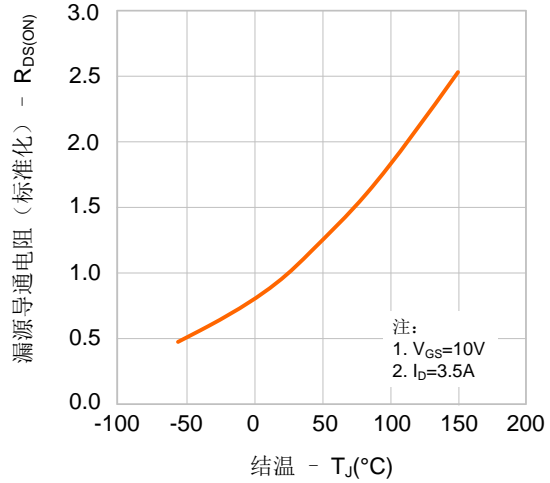


图 9-1. 最大安全工作区域 (SVSP11N70F/FJHD2)

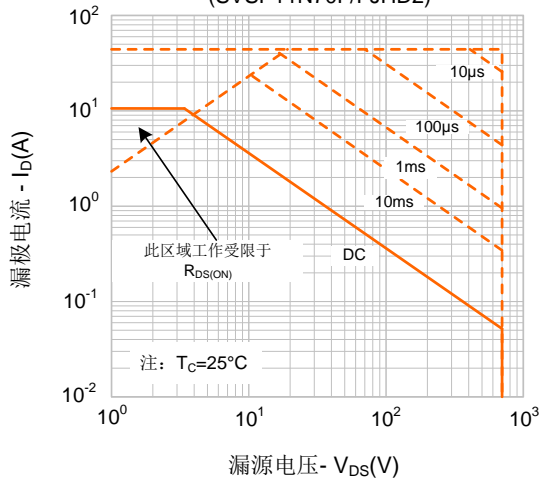


图 9-2. 最大安全工作区域 (SVSP11N70D/MJD2)

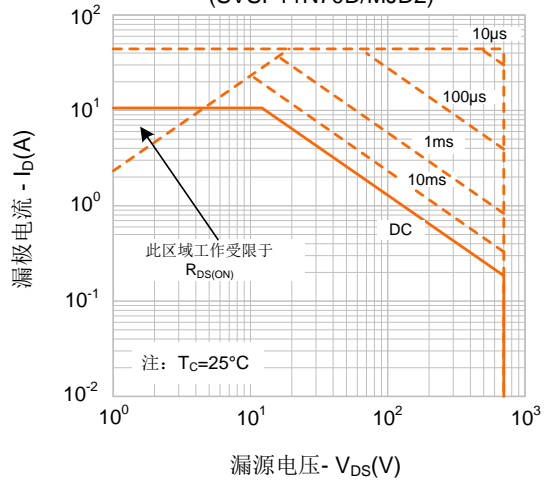
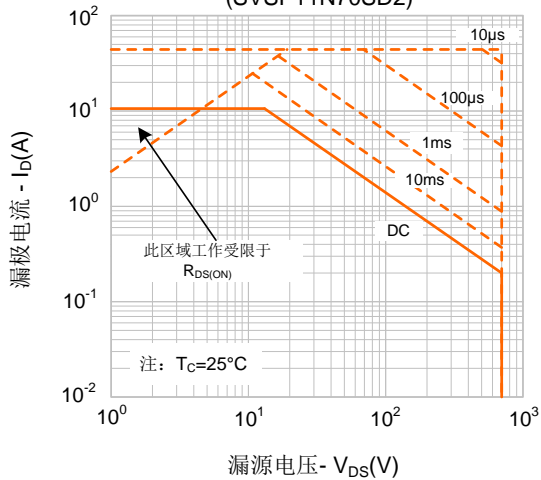
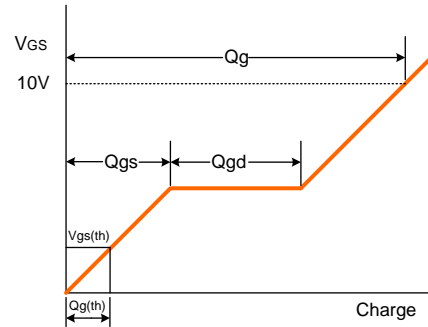
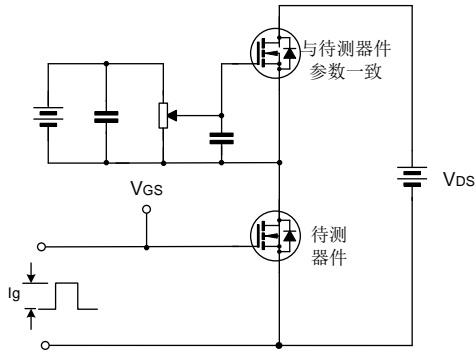


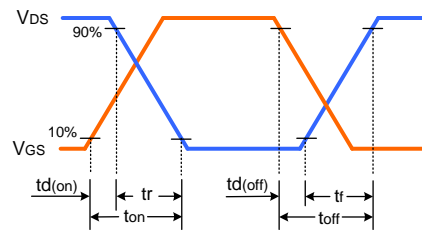
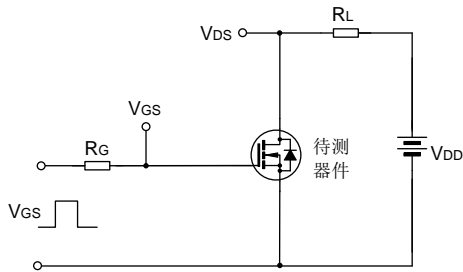
图 9-3. 最大安全工作区域 (SVSP11N70SD2)



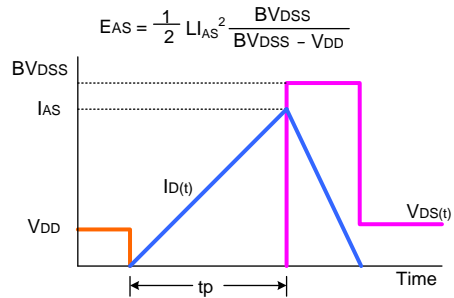
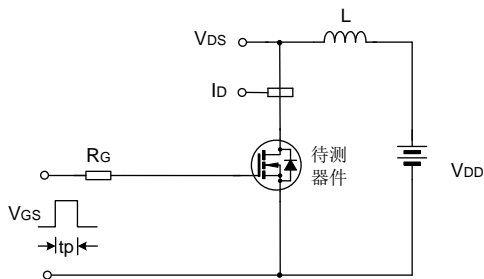
典型测试电路



栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图

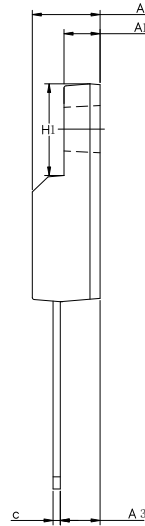
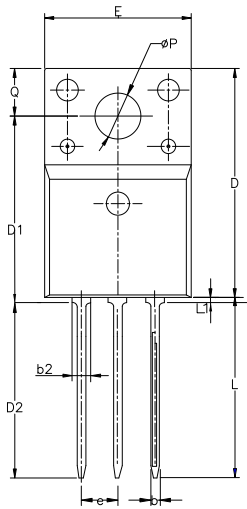


EAS测试电路及波形图

封装外形图

TO-220FJH-3L

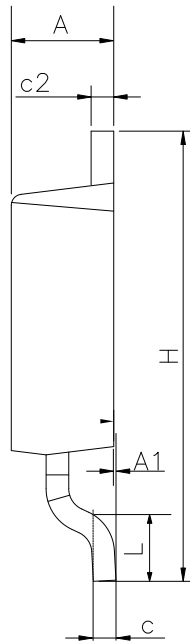
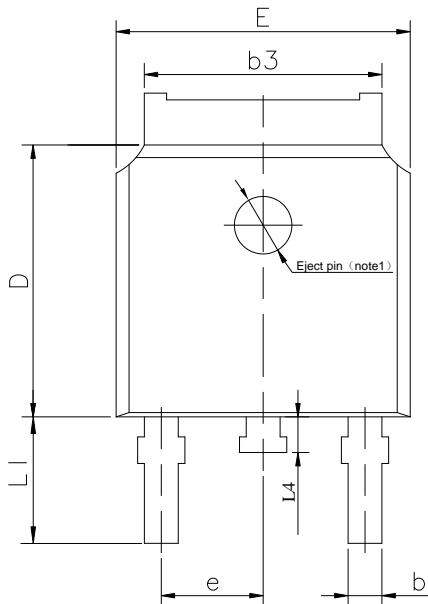
单位: mm



SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.55	0.70	0.80
b2	—	—	1.29
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	12.87	13.07	13.27
D2	12.28	12.48	12.68
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BCS		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	—	—	0.85
ØP	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

TO-252-2L

单位: mm



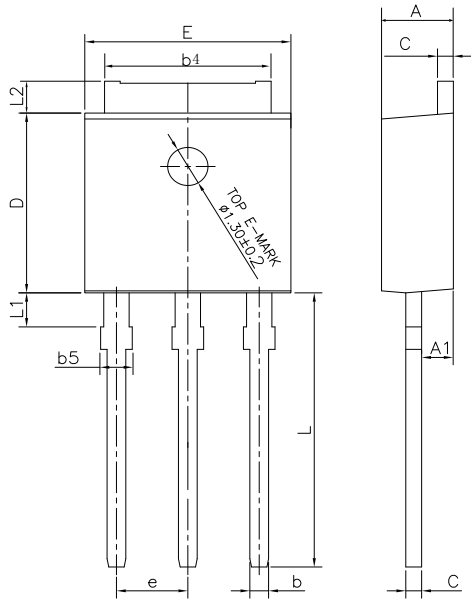
SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	2.10	2.30	2.50
A1	0	---	0.127
b	0.66	0.76	0.89
b3	5.10	5.33	5.46
c	0.45	---	0.65
c2	0.45	---	0.65
D	5.80	6.10	6.40
E	6.30	6.60	6.90
e	2.30TYP		
H	9.60	10.10	10.60
L	1.40	1.50	1.70
L1	2.90REF		
L4	0.60	0.80	1.00

NOTE1 : There are two conditions for this position:has an eject pin or has no eject pin.

封装外形图(续)

TO-251J-3L

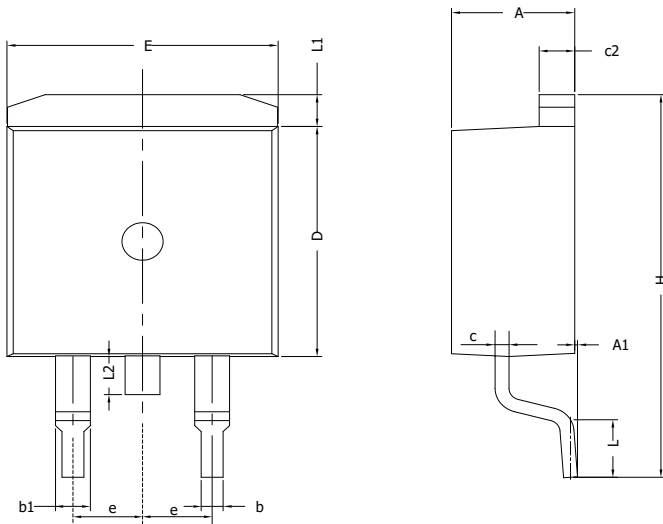
单位: mm



SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	2.18	2.30	2.39
A1	0.89	1.00	1.14
b	0.56	---	0.89
b4	4.95	5.33	5.46
b5	---	---	1.05
c	0.46	---	0.61
D	5.97	6.10	6.27
E	6.35	6.60	6.73
e	2.29 BCS		
L	8.89	9.30	9.65
L1	0.95	---	1.50
L2	0.89	---	1.27

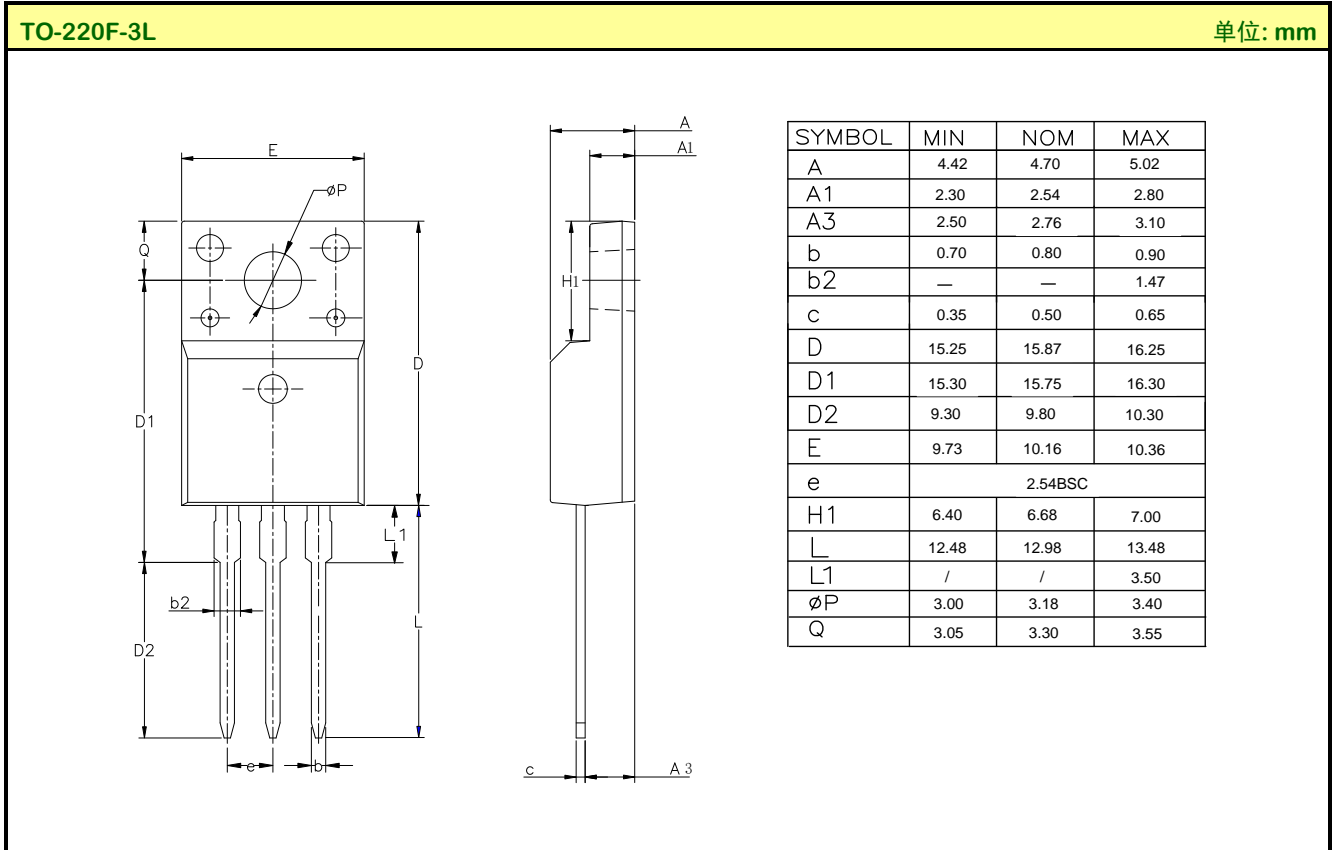
TO-263-2L

单位: mm



SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.30	4.57	4.72
A1	0	0.10	0.25
b	0.71	0.81	0.91
c	0.30	---	0.60
c2	1.17	1.27	1.37
D	8.50	---	9.35
E	9.80	---	10.45
e	2.54BSC		
H	14.70	---	15.75
L	2.00	2.30	2.74
L1	1.12	1.27	1.42
L2	---	---	1.75



**封装外形图(续)**

**重要注意事项：**

- ◆ 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。
- ◆ 我司产品属于消费类和/或民用类电子产品。
- ◆ 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值，否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
- ◆ 购买产品时请认清我司商标，如有疑问请与本公司联系。
- ◆ 转售、应用、出口时请遵守中国、美国、英国、欧盟等国家、地区和国际出口管制法律法规。
- ◆ 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！
- ◆ 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

---

产品名称:	SVSP11N70F/FJH/D/MJ/SD2	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	<a href="http://www.silan.com.cn">http://www.silan.com.cn</a>

---

版 本: 1.1

修改记录:

1. 修改电气图和典型电路图
  2. 删除命名规则
- 

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式版本发布
-